



ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ 2Т3135А-1, 2Т3135Б-1

Изготовитель РЗПП АО "Альфа", г.Рига,
 тел. 371 7553075, www.alfarzp.lv
 Ген.представитель в России ОАО "Альфа",
 г.Москва, www.alfarzp.ru

2Т3135А-1 63 4114 8185
 2Т3135Б-1 63 4120 0515

ЭТИКЕТКА

Бескорпусные кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р транзисторы 2Т3135А-1, 2Т3135Б-1, предназначенные для применения в аппаратуре в составе гибридных интегральных микросхем.

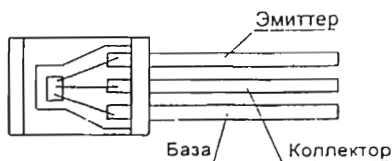
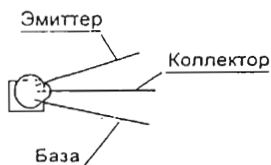
Маркировка транзисторов в соответствии с техническими условиями аА0.339.344 ТУ.

Сертификат ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) № РОСС LV.ИС46.К00038.

Заключение об аттестации № СВС.01.434. *0,392.05 05-16-02.05*

Схема расположения выводов

Расположение выводов транзистора в таре сопроводительной



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Основные электрические параметры ($t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$)

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{кб} = 15 \text{ В}$), мкА	$I_{кб0}$		1
Обратный ток эмиттера ($U_{эб} = 4 \text{ В}$), мкА	$I_{эб0}$		1
Статический коэффициент передачи тока ($U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 3 \text{ мА}$, $t_x \leq 2 \text{ мс}$)	h_{213}	50	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 3 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ МГц}$)	$ h_{213} $	15	
Время рассасывания ($I_x = 10 \text{ мА}$, $I_6 = 0,5 \text{ мА}$), нс	t_{pac}		10

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 3 \text{ мА}$, $f = 30 \text{ МГц}$), пс	τ_k		50
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_k = 10 \text{ мА}$, $I_э = 1 \text{ мА}$), В	$U_{кэнас}$		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_k = 10 \text{ мА}$, $I_э = 1 \text{ мА}$), В	$U_{бэнас}$		1,1
Емкость коллекторного перехода ($U_{кб} = 10 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ	C_k		1,5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{эб} = 0 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$), пФ	$C_э$		2

1.2. Содержание драгоценных металлов

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт транзисторов 2Т3135Б-1:

- золото 0,4788 г,

в том числе в одном транзисторе

- золото 0,000478 г/мм на 3 выводах длиной (6 ± 3) мм.

Драгоценных металлов в транзисторе 2Т3135А-1 не содержится. ✓

1.3. Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится.

2. НАДЕЖНОСТЬ

2.1. Гамма-процентный ресурс транзисторов при $\gamma = 95 \%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, не менее 100000 ч.

2.2. Срок хранения транзисторов с даты отгрузки до их герметизации в составе ГС (микросборок) 18 месяцев.

Минимальный срок сохраняемости транзисторов в составе ГС 25 лет при хранении в отапливаемом хранилище, хранилищах с кондиционированием воздуха, смонтированных в защищенную аппаратуру в комплекте ЗИП.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям аА0.339.344 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на транзисторы.

Гарантийный срок 25 лет с даты монтажа в ГС.

Гарантийная наработка:

- 50000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
- 100000 ч - в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т3135А-1, 2Т3135Б-1 соответствуют техническим условиям аА0.339.344 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 11 от 20.09.2005



Handwritten signature

- СЕН 2005



Штамп "Перепроверка произведена _____"
(дата)

Приняты по извещению № _____ от _____

Штамп ОТК